

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成29年9月7日(2017.9.7)

【公開番号】特開2017-10016(P2017-10016A)

【公開日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【年通号数】公開・登録公報2017-002

【出願番号】特願2016-111345(P2016-111345)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/40 (2006.01)

G 0 3 F 7/038 (2006.01)

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

C 0 8 F 293/00 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/40 5 1 1

G 0 3 F 7/038 6 0 1

G 0 3 F 7/039 6 0 1

G 0 3 F 7/20 5 2 1

C 0 8 F 293/00

【誤訳訂正書】

【提出日】平成29年7月12日(2017.7.12)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項 1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項 1】

パターン処理法であって、

(a) 表面にパターン形成された特徴部を備える半導体基板を提供することと、

(b) パターン処理組成物を前記パターン形成された特徴部に塗布することであって、前記パターン処理組成物がブロックコポリマー及び溶媒を含み、前記ブロックコポリマーが第 1 のブロック及び第 2 のブロックを含み、前記第 1 のブロックがエチレン性不飽和重合性基及び水素受容体基を含む第 1 のモノマーから形成された単位を含み、前記水素受容体基が窒素含有基であり、前記第 2 のブロックがエチレン性不飽和重合性基及び環式脂肪族基を含む第 2 のモノマーから形成された単位を含む、塗布することと、

(c) 残留パターン処理組成物を前記基板からすすいで、前記パターン形成された特徴部に結合した前記ブロックコポリマーを残すことと、

(d) エッチングマスクとして前記パターン形成された特徴部及び前記結合したブロックコポリマーを用いて前記パターン形成された特徴部の下にある層をエッチングすることと、を含む、前記パターン処理法。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 1 1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【 0 0 1 1 】

本発明のさらなる態様に従って、パターン処理法が提供される。本方法は、(a) 表面上にパターン形成された特徴部を備える半導体基板を提供することと、(b) パターン処

理組成物をパターン形成された特徴部に塗布することであって、パターン処理組成物がブロックコポリマー及び溶媒を含み、ブロックコポリマーが第１のブロック及び第２のブロックを含み、第１のブロックがエチレン性不飽和重合性基及び水素受容体基を含む第１のモノマーから形成された単位を含み、水素受容体基が窒素含有基であり、第２のブロックがエチレン性不飽和重合性基及び環式脂肪族基を含む第２のモノマーから形成された単位を含む、塗布することと、(c) 残留パターン処理組成物を基板からすすいで、パターン形成された特徴部に結合したブロックコポリマーの一部を残すこととを含む。